

InGaAs PIN фотодиоды ДФД1000ТО-К

Особенности

- Высокая чувствительность на 1.3 мкм и 1.55 мкм
- Спектральный диапазон 0.85-1.7 мкм
- Низкий темновой ток
- Активный диаметр 1000 мкм
- Конструкция с вводом излучения через мезаструктуру
- Корпус типа ТО-18

Области применения

- Измерительная аппаратура для ВОЛС
- Сенсоры
- Спектроскопия
- Приемные модули с предусилителем

Краткое описание

PIN InGaAs/InP фотодиоды типа ДФД1000 созданы для прямого преобразования оптических сигналов в электрические в ближнем инфракрасном диапазоне. Модель ДФД1000 разработана для использования в волоконно-оптических лазерных излучателях для создания обратной связи и имеют конструкцию с вводом излучения через мезаструктуру с относительно большими активными размерами 1000 мкм. Фотодетекторы ДФД1000 также используются для оптических линий связи и различных ИК датчиков. Фотодиод поставляется в корпусе типа ТО-18 со стеклянным окном.

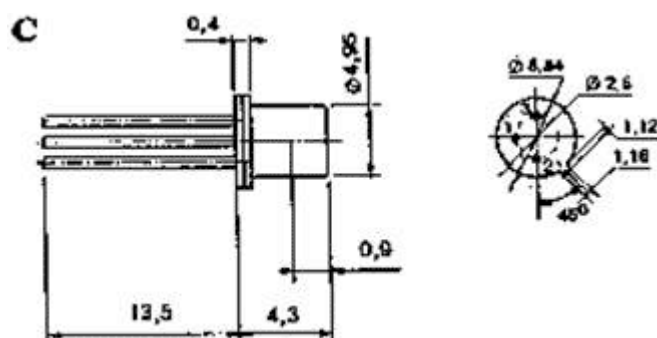


Технические характеристики ($V_r = -5V$, $25^\circ C$)

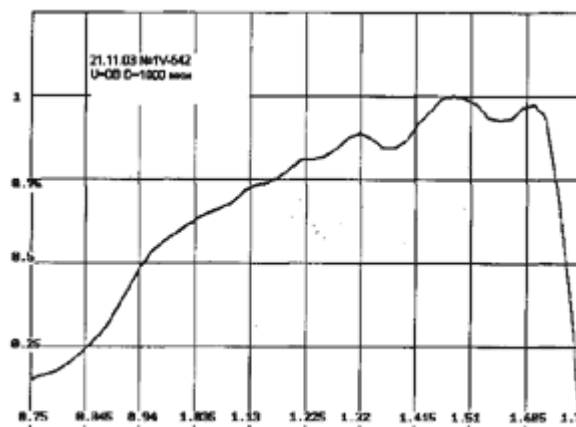
Модель	Фото- чувств. плещ., мкм	Спектральная чувствительность, А/Вт						Темновой ток, нА		Ёмкость, пФ		Корпус. исполн.
		850 нм		1300 нм		1550 нм		тип	макс	тип	макс	
		мин	тип	мин	тип	мин	тип					
ДФД1000ТО-К	1000	0.15	0.20	0.75	0.85	0.80	0.90	20	40	35.0	40	С

Предельно допустимые значения

Напряжение обратного смещения	10 В
Обратный фототок	3 мА
Прямой ток	5 мА
Рабочая температура	-60...+55°C



Контакты: 1. Катод ("+" смещение) **Размеры: мм**
2. Анод ("-" смещение)
3. Корпус



Спектральная характеристика

НПФ «Дилаз»
Россия, Москва
тел (495) 104-05-51
факс (495) 333-05-13
e-mail: dilas@mail.magelan.ru